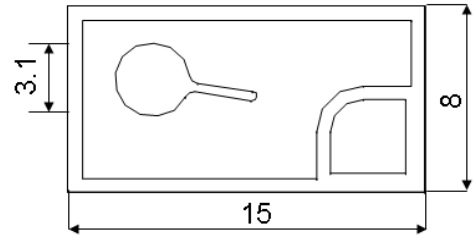




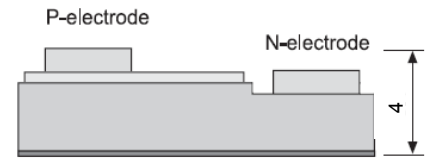
◆ 产品特点:

- 高亮度、长寿命
- 户内外应用
- 芯片百分百测试分选
- 波长和光强良好一致性



◆ 物理参数:

P 电极	金
N 电极	金
芯片尺寸	15mil × 8mil (381±25μm×203±25μm)
芯片厚度	4mil (100 ± 15μm)
焊盘尺寸	3.1mil (80±10μm) in diameter



单位: mil

Reflector

◆ 光电参数: (Tc=22°C, I_F=20mA)

产品型号	波长范围 (λ _D , nm)		工作电压 (V _F , V)	反向漏电流 (I _R , μA) @V _R =10V	半波宽度 (Δλ, nm)	最大电流 (I _F , mA) DC
	Min	Max				
S-15ABMUP*-445E***	445	450	≤3.4	≤2	≤30	30
S-15ABMUP*-450E***	450	455				
S-15ABMUP*-455E***	455	460				
S-15ABMUP*-460E***	460	465				
S-15ABMUP*-465E***	465	470				

◆ 光强等级: (Tc=22°C, I_F=20mA)

等级	...	D16	D17	D18	D19	D20	D21	...
I _v avg (mW)	...	14.0-15.5	15.5-17.0	17.0-18.5	18.5-20.0	20.0-21.5	21.5-23.0	...

◆ 其它说明:

- 光电参数均系三安光电测试仪器在晶圆条件下的测试参数, 98%符合标称值范围
- 芯片封装工艺最高温度低于 280°C, 持续时间小于 10 秒
- GaN LED 芯片为静电敏感产品, 使用、运输时注意静电防护
- 主波长测量误差 ± 1.0nm
- 可根据客户要求订做特殊规格的芯片